

2SC1975

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ型 / Si NPN Epitaxial Planar

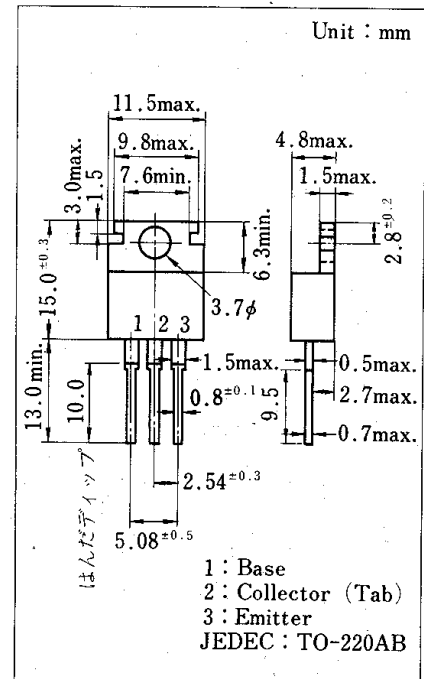
トランシーバ送信出力用 / Transceiver Power Output

特徴 / Features

- 破壊強度が大きい。 / Withstands worst overload conditions.
- 高耐圧 / $V_{CBO} = 120V$

最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ C$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	120	V
コレクタ・エミッタ電圧 ($R_{BE} = 100\Omega$)	V_{CER}	90	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CM}	3	A
コレクタ電流	I_C	2	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ C$)	P_C	12	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ C$



電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ C$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C = 1mA, I_E = 0$	120			V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CER}	$I_C = 2mA, R_{BE} = 100\Omega$	90			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E = 10\mu A, I_C = 0$	5			V
コレクタしゃ断電流	I_{CEO}	$V_{CE} = 40V, I_B = 0$			1	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = 5V, I_C = 1A$	50		200	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 2A, I_B = 0.2A$		0.6	1	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = 5V, I_C = 500mA$		150		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 10V, I_E = 0, f = 1kHz$		40		pF
出力電力	P_o	$V_{CC} = 13.5V, f = 27MHz, P_{in} = 0.2W$	3.8	4.2		W